اشكان شكيبا (9931030)

آزمایش نهم مدار های الکتریکی و الکترونیکی

عنوان آزمایش:

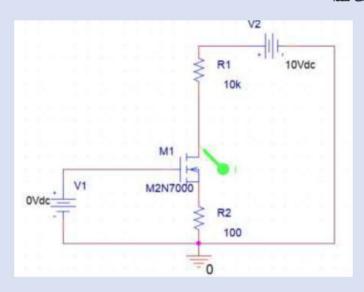
آشنایی با ترانزیستور های MOS

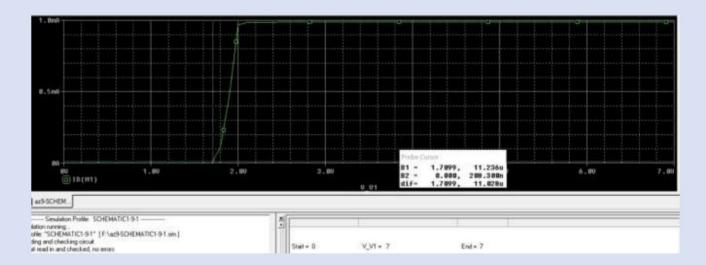
هدف از انجام آزمایش:

آشنایی با ترانزیستور های MOS و نحوه عملکرد آنها

آزمایش 9-1: تعیین ولتاژ آستانه ترانزیستور NMOS

ابتدا با استفاده از یکی از ترانزیستورهای NMOS موجود در تراشه CD4007 مدار شکل زیر را بسازید. در این بخش با استفاده از اختالف پتانسیل ایجاد شده بین درین و سورس میزان ولتاژ آستانه ترانزیستور تعیین خواهد گرد. برای یافتن مقدار ولتاژ آستانه ابتدا منبع تغذیه مربوط به ولتاژ گیت را بر روی صفر تنظیم کرده و سپس به آرامی مقدار آن را افزایش دهید. هنگامی که عبور جریان از مقاومت درین آغاز گردد. (جریان درین به مقدار 0.1 میلی آمپر برسد.) ترانزیستور روشن شده است. در حقیقت با افزایش تدریجی ولتاژ منبع تغذیه مقدار Vgs افزایش مییابد و به ولتاژ آستانه میرسد و ترانزیستور روشن خواهد شد. به محض اینکه جریان درین به مقدار خواسته شده رسید، ولتاژ گیت-سورس نشاندهنده ولتاژ آستانه خواهد بود. Vt حدودا برابر با 1.70 ولت شد!



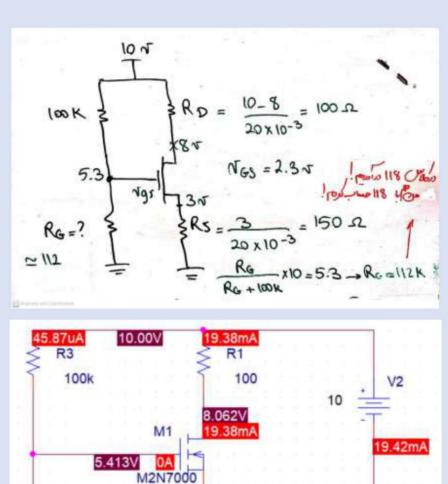


آزمایش 9-2: بایاس ساده ترانزیستور NMOS

با استفاده از نتیجه بدست آمده برای ولتاژ آستانه، مقاومت سورس را طوری انتخاب کنید که جریان درین 21mA باشد. مقاومت درین را طوری انتخاب کنید که ولتاژ درین 8V شود.

ولتاژ درین و سورس را اندازه بگیرید و با مقدار تئوری خود مقایسه کنید.

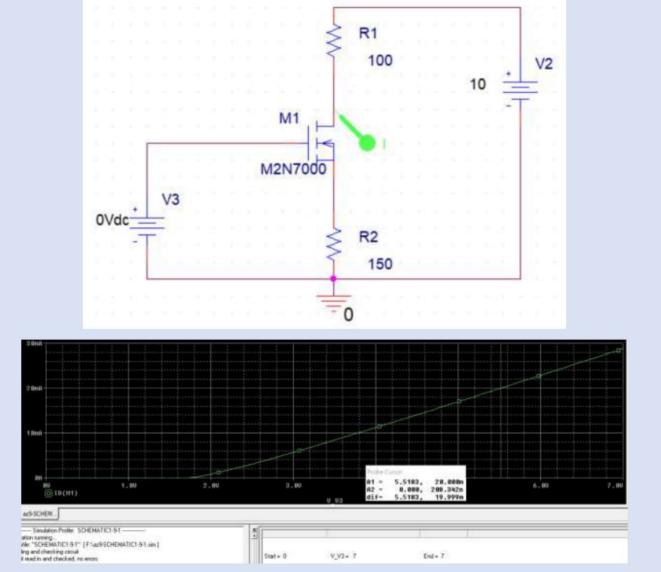
محاسبات تئورى:



2.907V 19.38mA

45.87uA

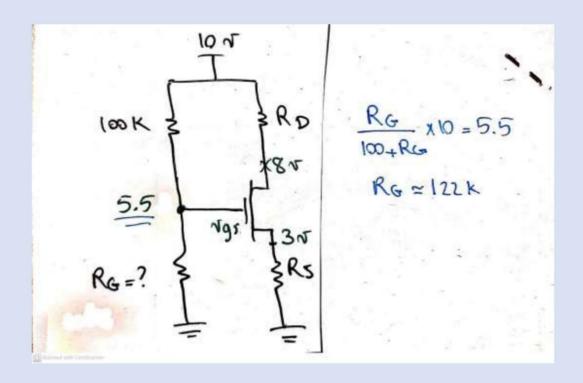
118k

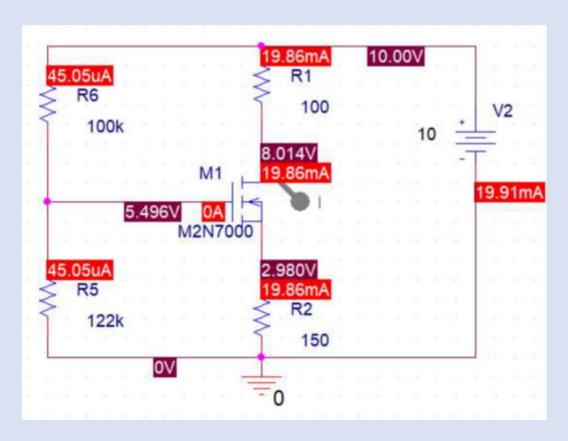


V_V3= 7

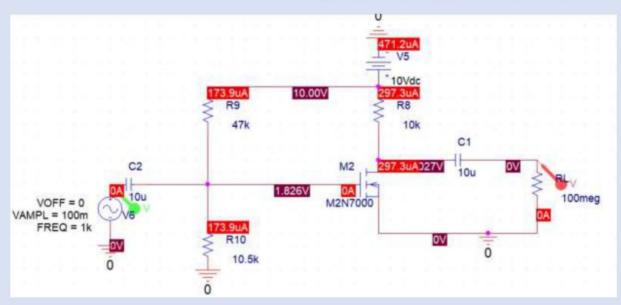
End = 7

طبق نمودار پس باید Vg را 5.5 بگذاریم.



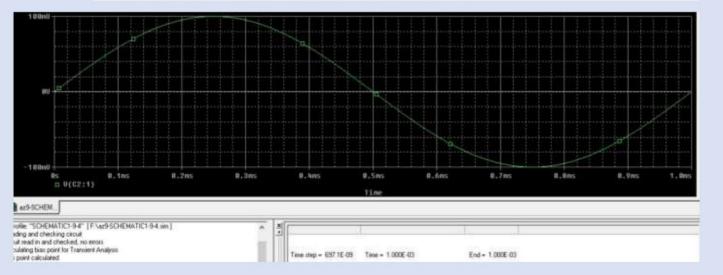


آزمایش 9-4: تقویت کننده سورس مشترک با ترانزیستورر NMOS



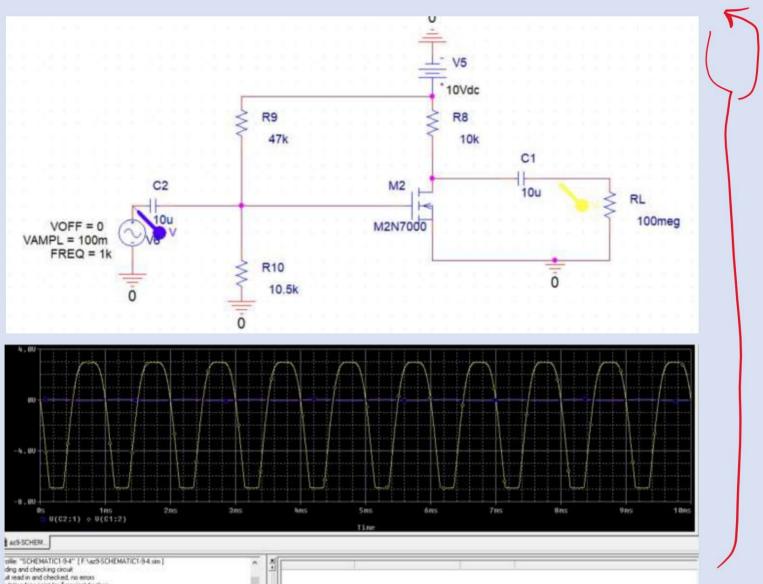
$$\sqrt{5} = \frac{10.5 \, \text{K}}{10.5 \, \text{K} + 47 \, \text{K}} \times 10 = 1.826 \, \text{K}$$

I_d V_d		V_g	پارامتر	
297.3MA	7.027 1	1.826 N	مقدار اندازه گیری شده	



1/20 / 100mA 1/5/20 (JUD)

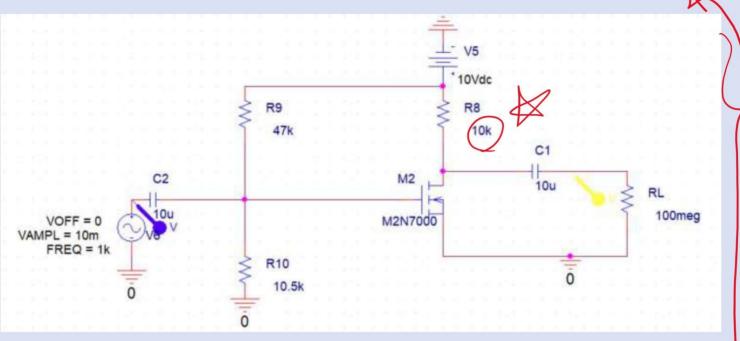
End = .01

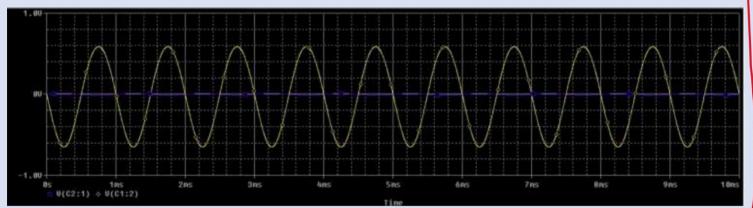


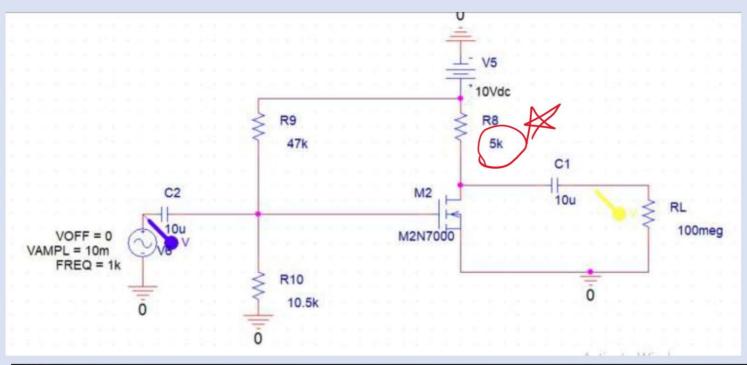
Time step = 491.1E-09 Time = .01

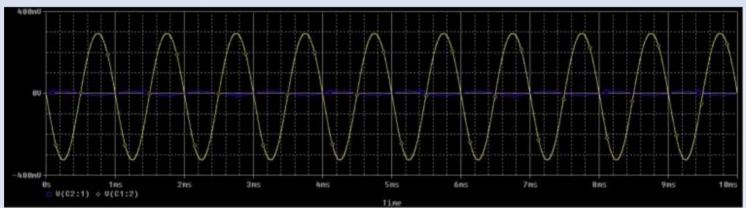
ulating bias point for Transient Analysis point calculated

در حالتی در دردی ۱۵۰۸ تعرف کنود!









درصد خطا	تئورى A_v	عملی A_v	V_o	V_{in}	R_d
27.6%	46	58.71	587.14 0	10 mV	\⋅ΚΩ
27.6%	23	29.36	293.6 V	10 mV	Δ ΚΩ